

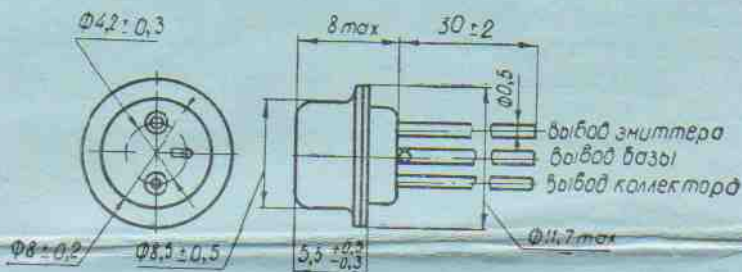


ПАСПОРТ

ТРАНЗИСТОРЫ ГЕРМАНИЕВЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ Р-П-Р ТИПОВ:

МП25, МП25А, МП25Б

Соответствуют ГОСТ 14830—75



Масса не более 2 г.

Примечание. Допускается длина выводов 40 ± 2 мм.
Для вновь разрабатываемой аппаратуры не применять.

1. Основные электрические параметры

Наименование параметра, режим измерения	Норма параметра					
	МП25		МП25А		МП25Б	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = -20$ В, $I_B = 2,5$ мА, $f = 1$ кГц, $t_{опр. ср.} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$, h_{210}	10	25	20	50	30	80
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = -10$ В, $t_{опр. ср.} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$, $I_{КБ0}$, мкА		75		75		75

Продолжение

Наименование параметра, режим измерения	Норма параметра					
	МП25		МП25А		МП25Б	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток эмиттера при $U_{об} = -40$ В, $t_{окр. ср.} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$, $I_{об0}$, мкА		75		75		75
Предельная частота коэффициента передачи тока при $U_{кб} = -20$ В, $I_a = 2,5$ мА, $t_{окр. ср.} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$, $f_{h21б}$, кГц	200		200		500	
Сопротивление базы при $U_{кб} = -20$ В, $I_a = 2,5$ мА, $f = 500$ кГц, $t_{окр. ср.} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$, r_b , Ом		160		160		160

2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра режима	Буквенн. обозн.	Норма параметра			Примечания
		МП25	МП25А	МП25Б	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор—база, В	$U_{кб max}$	-40	-40	-40	2
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер—база, В	$U_{об max}$	-40	-40	-40	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор—эмиттер, В	$U_{кэ max}$	-40	-40	-40	2
Максимально допустимый постоянный ток коллектора (эмиттера) в режиме насыщения, мА	$I_{к нас max}$ ($I_{э нас max}$)	300	400	400	
Постоянная рассеиваемая мощность, мВт	P	200	200	200	1
Максимально допустимый интервал рабочих температур, $^\circ\text{C}$	$t_{окр. ср.}$	от -60 до +70			

Примечания: 1. Постоянная рассеиваемая мощность при $t_{окр. ср.}$ свыше $+35^\circ\text{C}$ рассчитывается по формуле:

$$P = \frac{75^\circ\text{C} - t_{окр. ср.}^\circ\text{C}}{0,2^\circ\text{C}/\text{мВт}} \text{ (мВт)}$$

2. При $t_{окр. ср.}$ до $+50^\circ\text{C}$ и при мощности, рассеиваемой транзистором, до 100 мВт допускается $U_{кб}$ и $U_{кэ}$ (при $R_{об} = 200$ Ом) минус 60 В.

3. Условия хранения приборов

Складские условия:

Температура окружающего воздуха может изменяться в пределах от $+5^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$, относительная влажность до 85%, отсутствие в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Полевые условия:

Температура окружающего воздуха может изменяться в пределах от -40°C до $+40^\circ\text{C}$, относительная влажность до 98% при температуре $+30^\circ\text{C}$.

4. Гарантии

Гарантийная наработка 15 000 часов. Гарантийный срок хранения — 8 лет с момента изготовления.

5. Указания и рекомендации по эксплуатации

1. В процессе работы не разрешается превышать предельно допустимые значения токов, напряжений и мощности во всем интервале температур.

2. При эксплуатации приборов в аппаратуре необходимо предусматривать условия, обеспечивающие замену любого прибора любым другим однотипным, удовлетворяющим требованиям стандарта на данный тип прибора. Отбор приборов с целью применения только лучших по параметрам образцов не допускается.

3. Рекомендуется эксплуатировать транзисторы в диапазоне температур от минус 50°C до $+55^\circ\text{C}$ при мощности, рассеиваемой транзистором до $0,7 P$, напряжениях до $0,7 U_{max}$ и токах до $0,7 I_{max}$. При этом увеличиваются гарантийная наработка транзисторов и надежность их работы.

4. При включении транзисторов в схемы, находящиеся под напряжением, вывод базы должен присоединяться первым и отключаться последним.

Работа в режиме обратной базы категорически воспрещена.

5. При эксплуатации в условиях ускорений более $19,62 \text{ м/с}^2$ транзисторы необходимо крепить за корпус.

6. Минимальное расстояние от места изгиба выводов до корпуса — 3 мм

7. Пайку следует производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора паяльником мощностью не более 30 Вт за время не бо

лее 5 с с использованием теплоотвода между местом пайки и корпусом транзистора или погружением в расплавленный припой с температурой не выше 260°C за время не более 5 с. При пайке рекомендуется применять флюс следующего состава: канифоль 40%; этиловый спирт технический 60%. Перед пайкой необходимо протирать выводы спиртом.

8. При заливке транзисторов компаундами, непластиками, пенорезинкой и др. температура их не должна превышать 70°C.

9. При заливке и полимеризации недопустимы механические воздействия, превышающие предельно допустимые, указанные в стандарте.

10. Интенсивность отказов λ в течение гарантийной наработки в режимах и условиях, рекомендуемых руководством по применению полупроводниковых приборов, должна быть не более $2 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Штамп ОТК

6. Рекламация

В случае преждевременного выхода из строя данный транзистор возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____
(заполняется, если прибор не был в эксплуатации)

Общее число часов работы прибора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

_____ (причины снятия прибора с эксплуатации или хранения,

_____ количество приборов данного типа, работавших в аналогичных

_____ условиях, но не отказавших, и общее число часов работы их)

Сведения заполнил _____

ВНИМАНИЕ!

По окончании эксплуатации прибора (если прибор снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6.